

PB7170P48 简要说明

版本：V1.0.6

[illegible]

目录

1	功能简介	4
2	应用领域	4
3	产品描述	4
4	产品信息	5
5	管脚定义	5
5.1	脚位图	5
5.2	脚位功能描述	6
6	内部框图	8
7	电气参数规格	9
7.1	极限电气参数	9
7.2	推荐工作范围	9
7.3	电气参数规格	10
8	典型工作特性	15
9	工作模式	16
9.1	关机模式	17
9.2	待机模式	17
9.3	测量模式	17
9.4	睡眠模式	18
10	功能描述	19
11	寄存器列表及定义	20
12	应用指引	20
12.1	典型应用电路	20
12.2	功能设计	21
12.3	减少电芯串联数量应用规则	24
12.4	引脚端口电路说明	25
12.5	注意事项	28
12.6	PCB 布线指引	28
13	包装	30
13.1	包装和器件机械尺寸	30
13.2	器件焊盘设计推荐	31

1 功能简介

- 工作电压范围：12-88V
工作温度范围：-40°C ~ +125°C（内部可设置 120°C 过温保护）
 - 关机模式功耗：2μA
 - 深睡模式功耗：5μA（数据保持）
 - 浅睡模式功耗：50μA（部分保护开启）
 - 测量模式功耗：150μA
- 电压和快速电流高精度测量：
 - 16bit VADC
 - +/-2mV @ 25°C, Vcell=3.6V
 - +/-5mV @ -20~85°C
 - +/-10mV @ -40~125°C
- 16bit 电流积分 CADC
 - 62.5mS/125mS/250mS 库仑计电流测量
- 17 组内部电芯均衡开关
 - 每个开关支持高达 100mA 的均衡电流
 - 均衡开关采用倒计时配置的安全设计
- 采集线，AUXIN 输入线断线检测
- 同时支持外部均衡 MOS
- 5 个用于热敏电阻或外部电压测量的辅助模拟输入
 - 独立的上下限阈值配置
- 数据测量自动调度设计
- 单次触发计时器（TIM）
- 系统报警
 - 电芯单体电压失配报警
 - 阈值可配的放电过流报警
 - 阈值可配的放电短路报警
 - 阈值可配的充电过流报警
 - 电芯单元过压和欠压报警
 - 增强故障诊断功能：内部自检测和断线检测
 - 芯片温度测量和报警
 - 外部测量（AUXIN）超限报警
- 系统保护
 - 充电/放电过流和放电短路保护
 - 低电压禁止充电保护
 - 外部下拉 ALERT 可快速关断充放电 MOS（外部保护）
 - 电芯单元过压和欠压保护
- SPI 通信。

- 独立中断引脚 ALERT

2 应用领域

PB7170P48 是一款应用于锂电池管理系统（battery management system, BMS）的高精度模拟前端（Analog front end, AFE）芯片，可广泛应用于电动自行车、电动摩托车、电动工具、通信、家庭和风光储能等 5 到 17 串电芯的锂电芯 BMS 系统中。

3 产品描述

PB7170P48 为多串锂电池管理芯片，可支持 5~17 串电芯应用。用于执行电池组的测量（单体电压，电池电流，电池组温度），保护（控制充放电 MOS）和均衡功能。单节电芯单体电压测量范围 0-5V，适用于大多数锂电池。

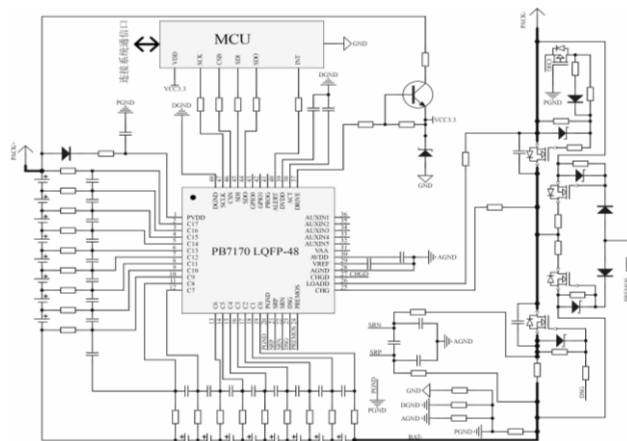
内置 VADC 模块，提供电压、温度和快速电流测量。内置 CADC 模块用于采集电流，用于库仑计方式的高精度 SOC 计量。

同时提供多种电流，电压，温度，充放电保护，提供 3 个充放电 MOS 控制引脚。

支持内部大电流均衡功能，单通道均衡电流可达 100mA，支持多单元均衡同时开启，支持多种智能均衡方式。

系统内部提供强大的自动调度系统，包含了配置定时测量和实时保护，通过中断引脚上报 MCU，可极大的节省系统资源和功耗。

提供多种低功耗睡眠模式。浅睡眠模式下，过流、短路保护等功能继续工作，可快速（200us 内）唤醒。深睡眠模式下，可达到极低功耗的系统状态保持。



4 产品信息

PB7170P48_XX	LQF48	250
--------------	-------	-----

产品编号	封装	最小包装
------	----	------

5 管脚定义

5.1 脚位图

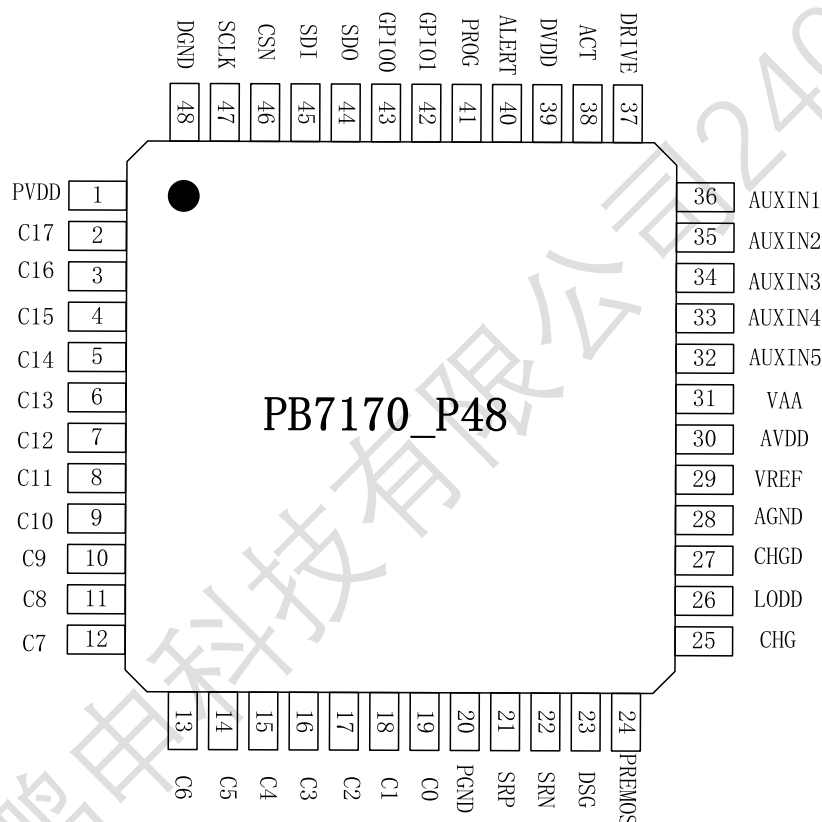


图 5.2 脚位图

PB7170P48 采用 LQFP48 封装。PVDD 为供电引脚；C0~C17 为电芯单元连接引脚；PGND 为电源地，AGND 为模拟地，DGND 为数字地。AUXIN1~AUXIN5 为外部电压测量信号输入引脚，连接 NTC 后可用于测量电芯、MOS 的温度。

SRP 和 SRN 为电流检测电阻的差分电压输入引脚。3 个充放电 MOS 的驱动引脚 (CHG/DSG/PREMOS) 可提供 10V 驱动电压。LODD 为负载检测输入引脚，CHGD 为外部充电器检测输入引脚。

VREF 为内部 ADC 基准电压，需要外接退耦电容。DRIVE 引脚提供 4V/5.7V 电压输出，芯片默认是 4V 输出，可配合外部 NPN 管为其他模块提供 3.3V/5V 供电。

SDO, SDI, CSN, SCLK 为 SPI 的通信引脚。

ALERT 为 AFE 中断输出引脚，同时作为外部保护的输入引脚。

5.2 脚位功能描述

引脚定义列表如下：

脚位	引脚名	功能	描述
1	PVDD	Power	高压直流供电正输入管脚，连接所测量电芯的最高电压点
2	C17	Input	电芯单元 17 的正极连接端口
3	C16	Input	电芯单元 16 的正极,电芯单元 17 的负极连接端口
4	C15	Input	芯单元 15 的正极,电芯单元 16 的负极连接端口
5	C14	Input	芯单元 14 的正极,电芯单元 15 的负极连接端口
6	C13	Input	芯单元 13 的正极,电芯单元 14 的负极连接端口
7	C12	Input	芯单元 12 的正极,电芯单元 13 的负极连接端口
8	C11	Input	芯单元 11 的正极,电芯单元 12 的负极连接端口
9	C10	Input	芯单元 10 的正极,电芯单元 11 的负极连接端口
10	C9	Input	芯单元 9 的正极,电芯单元 10 的负极连接端口
11	C8	Input	芯单元 8 的正极,电芯单元 9 的负极连接端口
12	C7	Input	芯单元 7 的正极,电芯单元 8 的负极连接端口
13	C6	Input	芯单元 6 的正极,电芯单元 7 的负极连接端口
14	C5	Input	芯单元 5 的正极,电芯单元 6 的负极连接端口
15	C4	Input	芯单元 4 的正极,电芯单元 5 的负极连接端口
16	C3	Input	芯单元 3 的正极,电芯单元 4 的负极连接端口
17	C2	Input	芯单元 2 的正极,电芯单元 3 的负极连接端口
18	C1	Input	芯单元 1 的正极,电芯单元 2 的负极连接端口
19	C0	Input	电芯单元 1 的负极连接端口
20	PGND	Ground	高压直流供电负输入，连接所测量电芯最低电压点
21	SRP	Input	电流检测传感器正端（接 PGND）
22	SRN	Input	电流检测传感器负端
23	DSG	Output	放电 MOS 驱动
24	PREMOS	Output	预充/放电 MOS 驱动
25	CHG	Output	充电 MOS 驱动
26	LODD	Input	负载检测输入引脚
27	CHGD	Input	充电器检测输入引脚
28	AGND	Ground	内部模拟电源地
29	VREF	Output	基准电压端口，需要外接退耦电容到 AGND
30	AVDD	Power	模拟电源输出引脚，需要外接退耦电容到 AGND
31	VAA	Power	外部测量输出电源，可用于给热敏电阻的分压网络供电
32	AUXIN5	Input	辅助测量端口 5，可以用于连接温度或其它传感器的模拟输出
33	AUXIN4	Input	辅助测量端口 4，可以用于连接温度或其它传感器的模拟输出
34	AUXIN3	Input	辅助测量端口 3，可以用于连接温度或其它传感器的模拟输出
35	AUXIN2	Input	辅助测量端口 2，可以用于连接温度或其它传感器的模拟输出
36	AUXIN1	Input	辅助测量端口 1，可以用于连接温度或其它传感器的模拟输出
37	DRIVE	Output	外部线性稳压三极管驱动电压，输出电压 4V/5.7V，连接 NPN 三极管的

			基极，可以在发射极获得 3.3V/5V 电压。可用于在低功耗模式下（DC-DC 关闭）为外部电路提供 3.3V/5V 工作电源。
38	ACT	Input	芯片激活引脚，高电平激活，外界需要接电容到地，内部有 8MΩ 上拉电阻。可短接到地进入超低功耗的关机模式
39	DVDD	Power	数字电源输出引脚，需要外接退耦电容到 DGND
40	ALERT	Input/Output	芯片中断信号开漏输出，低电平有效。同时作为外部保护输入引脚，如果被外部强制拉低，将触发外部保护。
41	PROG	Input	接 DGND
42	GPIO1	Input/Output	通用输入输出引脚 1
43	GPIO0	Input/Output	通用输入输出引脚 0
44	SDO	Output	SPI 从机数据输出引脚，推荐 47K 电阻接地
45	SDI	Input	SPI 从机数据输入引脚
46	CSN	Input	SPI 从机片选引脚，睡眠时低电平唤醒 AFE
47	SCLK	Input	SPI 从机时钟输入引脚
48	DGND	Ground	数字电源地

表 5.2 引脚定义

6 内部框图

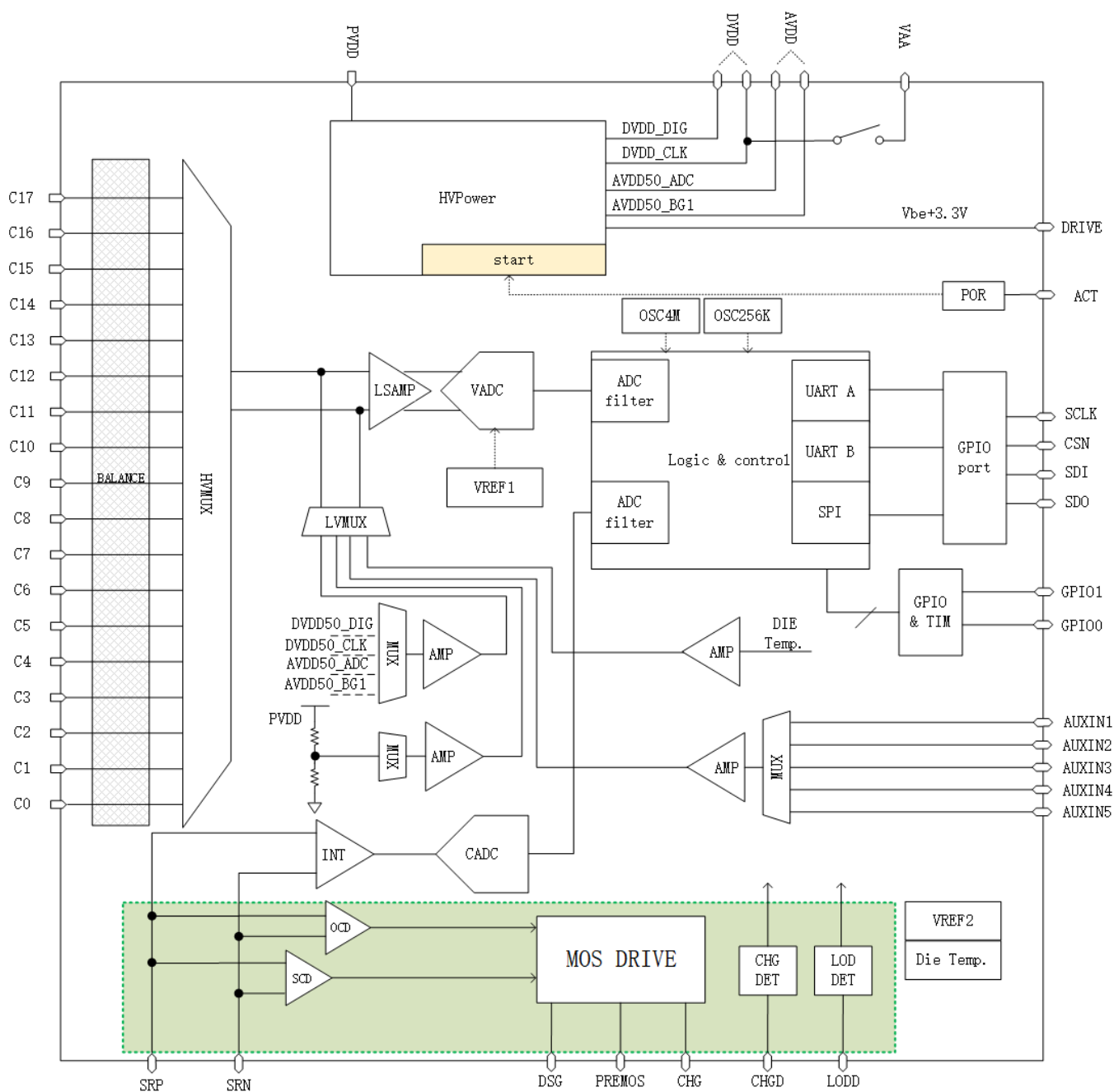


图 6 内部框图

7 电气参数规格

7.1 极限电气参数

端口	说明	最小值	最大值	单位
PVDD	$V_{PVDD} - V_{PGND}$	-0.5	88	V
C_n	$V_{Cn} - V_{Cn-1}, n=1-17$	-0.5	10	V
AUXIN 输入电压	$V_{AUXIN} - V_{AGND}$	-0.5	5.5	V
电流采样电压	$V_{SRP} - V_{SRN}$	-500	500	mV
MOS 驱动输出	CHG, DSG, PREMOS	-0.5	20	V
DRIVE 输出		-0.5	10	V
数字信号	CSN, SDI, SDO, SCLK, ALERT GPIO0, GPIO1, PROG	-0.5	5.5	V
其它端口	DVDD, AVDD, ACT, VAA, VREF, CHGD, LODD, SPR, SRN	-0.5	5.5	V
内部均衡电流	单个 CELL		150	mA
工作温度		-40	125	°C
存储温度		-65	150	°C
焊接温度	持续时间 10S		300	°C
ESD HBM			2	kV
ESD CDM			500	V

表 7.1 极限参数规格

7.2 推荐工作范围

信号	说明	最小值	最大值	单位
总电源电压	$V_{PVDD} - V_{PGND}$	12	80	V
电芯单体电压	$V_{Cn} - V_{Cn-1}, n=1-17$	-0.5	5	V
AUXIN 输入电压	$V_{AUXIN} - V_{AGND}$	0.5	4.5	V
电流输入	$V_{SRP} - V_{SRN}$	-230	230	mV
MOS 驱动输出	CHG, DSG, PREMOS	0	13	V
DRIVE 输出	可配置 4V/5.7V	0	4/5.7	V
数字信号输入	CSN, SDI, SCLK, ALERT	0	3.6	V
数字信号输出	SDO, GPIO0, GPIO1, ALERT	0	3.6	V
内部均衡电流	单个 CELL		100	mA
工作温度		-20	85	°C

表 7.2 推荐工作范围

7.3 电气参数规格

 以下电气特性，均在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 测量

工作电流						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{PVDD}	关机模式	ACT 引脚拉低		2		μA
	浅睡模式	电流保护开启, CADC 开启		90		μA
		电流保护开启, CADC 关闭		60		μA
	深睡模式	电流保护关闭, CADC 关闭		5		μA
	测量模式	调度模式:250mS 测量间隔 电流电压保护开启, CADC 开启		150		μA
VADC 电压/外部测量						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{RANGE}	测量范围		-0.5		5	V
V_{LSB}	LSB			100		μV
$V_{\text{ACC1}}^{\text{注1}}$	测量精度	$T_A=25^{\circ}\text{C}$ $V_{\text{cell}}=3.6\text{V}$	-2		2	mV
		-20~85 $^{\circ}\text{C}$	-5		5	mV
		-40~125 $^{\circ}\text{C}$	-10		10	mV
T_{VADC}	单通道采样时间	通过 VADC_MSR [2:0]	128	512	4096	时钟周期
VADC 快速电流测量						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
C_{RANGE}	测量范围		-300		300	mV
C_{ACC}	测量精度				± 1	mV
T_{C}	采样时间			512		时钟周期
CADC 电流积分						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
RANGE_{CC}	测量范围		-250		250	mV
LSB_{CC}	LSB	62.5mS 积分		31.25		μV
		125mS 积分		15.625		μV

		250mS 积分		7.8125		μV
T_{CC}	转换时间	CADC_SIZE =1		62.5		mS
		CADC_SIZE =2		125		mS
		CADC_SIZE =3		250		mS
CC_{INL}	积分非线性误差			± 1		LSB
芯片内部温度						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DIE25}	对应温度的电压	$T_A=25^{\circ}\text{C}$		2043		mV
$V_{DIEDRIFT}$	温度漂移			-5.917		mV/ $^{\circ}\text{C}$
内外部供电						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DRIVE}	DRIVE 电压	DRV_REFOPT 配置为 1 输出 5.7V, 配置为 0 输出为 4V		4/5.7		V
I_{DRIVE}	DRIVE 电流	PVDD=80V			5	mA
		PVDD=12V			30	mA
V_{VAA}	VAA 电压			5		V
V_{AVDD}	AVDD 电压			5		V
V_{DVDD}	DVDD 电压			3.3		V
MOSFET 驱动						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{MOS_ON}	MOS 驱动电压	CHG, DSG, PREMOS	8	10	13	V
T_{MOS_ON}	上拉开启时间	负载电容 20nF		25		μS
T_{MOS_OFF}	下拉关闭时间	负载电容 20nF		25		μS
R_{CHG_OFF}	CHG 关闭阻抗			130		Ω
R_{DSG_OFF}	DSG 关闭阻抗			130		Ω
R_{premos_OFF}	Premos 关闭阻抗			130		Ω
过压保护						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位

V _{OV}	过压保护电压阈值	通过寄存器 THR_OVSET [12:0]配置	0	4.2	6.5	V
V _{OVR}	过压恢复电压阈值	通过寄存器 THR_OVCLR [12:0]配置	0	4.3	6.5	V
N _{OV}	过压保护延迟时间	通过寄存器 DLY_OVUV [11:9]配置	1	1	8	次
欠压保护						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{UV}	欠压保护电压阈值	通过寄存器 THR_UVSET [12:0]配置	0	2.8	6.5	V
V _{UVR}	欠压恢复电压阈值	通过寄存器 THR_UVCLR [12:0]配置	0	2.9	6.5	V
N _{UV}	欠压保护延迟时间	通过寄存器 DLY_OVUV [5:3]配置	1	1	8	次
放电过流保护						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OD}	放电过流保护门限电压	通过寄存器 THR_CD[4:0]配置	10	10	200	mV
T _{OD}	放电过流保护延迟时间	通过寄存器 PROT_CTRL [10:7]配置	10	10	1280	mS
放电短路保护						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{SD}	短路保护门限电压	通过寄存器 THR_CD [9:5]配置	20	20	400	mV
T _{SD}	短路保护延迟时间	通过寄存器 PROT_CTRL [6:3]配置	0	0	448	μS
充电过流保护						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OC}	充电过流保护门限电压	通过寄存器 THR_CD [14:10]配置	10	10	200	mV
T _{OC}	充电过流保护延迟时间	通过寄存器 PROT_CTRL [2:0]配置	10	10	1280	mS
低电压禁止充电						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位

V _{LV}	低电压禁止充电设置电压	通过寄存器 THR_LV 配置阈值	1.638	2.5	3.25	V
ALERT 引脚						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{ALERT_OH}	ALERT 输出高	ALERT 外部上拉	2.5	3.3		V
V _{ALERT_OL}	ALERT 输出低	I _{OL} = 1mA, ALERT 外部上拉, 建议放置 4.7K 外部上拉电阻	0	0	0.6	V
V _{ALERT_IH}	ALERT 输入高		2.5		3.6	V
V _{ALERT_IL}	ALERT 输入低	ALERT 外部下拉	-0.3		0.6	V
充电器/负载/小电流检测						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{CHGD}	CHGD 检测电压	CHG 断开	-950	-500		mV
V _{LODD}	LODD 检测电压	DSG 断开		1	1.7	V
R _{CHGD}	CHGD 内部下拉电阻			2.8M		Ω
R _{LODD}	LODD 内部下拉电阻			100k		Ω
V _{IDET}	小电流检测电压	CMPCD_VTHSEL=3		2		mV
均衡						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
R _{BL}	均衡内阻	内部均衡 MOS 的 R _{ds_on}		5		Ω
T _{BL}	均衡开启时间	通过 BLSW_CMD 配置	0.25		1020	S
V _{BL}	停止放电电压	通过 BLSW_THR_UV 配置		2.8		V
X _{BL}	占空比	PWM 周期为 250ms 占空比用 BLSW_PWM_DUTY 调节	12.5	12.5	100	%
I _{BL}	均衡电流	单通道			100	mA

工作模式切换						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{ACT}	激活电压	ACT 对 AGND 关机模式切换到待机模式	2.5	3.3	5	V
V_{SD}	关机电压	ACT 对 AGND 待机模式切换到关机模式	0	0	0.6	V
T_{wakeup}	深睡 唤醒时间	DEEP = 1 睡眠模式切换到 待机模式	0.9	1	1.1	mS
	浅睡 唤醒时间	DEEP = 0 睡眠模式切换到 待机模式	180	200	250	μ S
数字输入输出						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IL}	输入 低 电 平	CSN,SCLK, SDI,ALERT,PROG	-0.3	0	0.6	V
V_{IH}	输入 高 电 平	CSN,SCLK, SDI,ALERT,PROG	2	3.3	4	V
V_{OL}	输出 低 电 平	GPIO0,GPIO1,SDO,ALERT	-0.3	0	0.4	V
V_{OH}	输出 高 电 平	GPIO0,GPIO1,SDO,ALERT	2.8	3.3	3.6	V
I_{OH}	上拉电流				16	mA
I_{OL}	下拉电流				16	mA
SPI 通信						
参数	说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Tclk	时钟周期		500			nS
Tcs_pre	CSN 提前 时间		20			nS
Tcs_post	CSN 延后 时间		50			nS
Thold	输入数据 保持时间		20			nS
Tsu	输入数据 建立时间		20			nS
Tdata	数 据 输 出 延迟				80	nS

表 7.3 电气参数规格

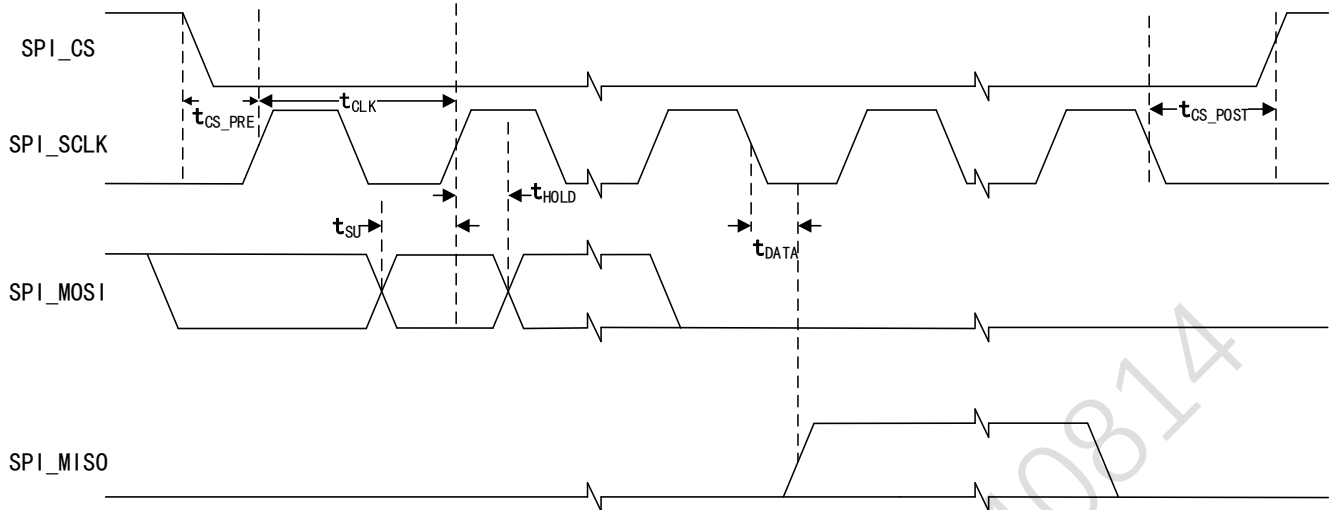


图 7.3 SPI 时序图

注 1: 测量绝对精度与外电路有关, 提供手动修调方案。

8 典型工作特性

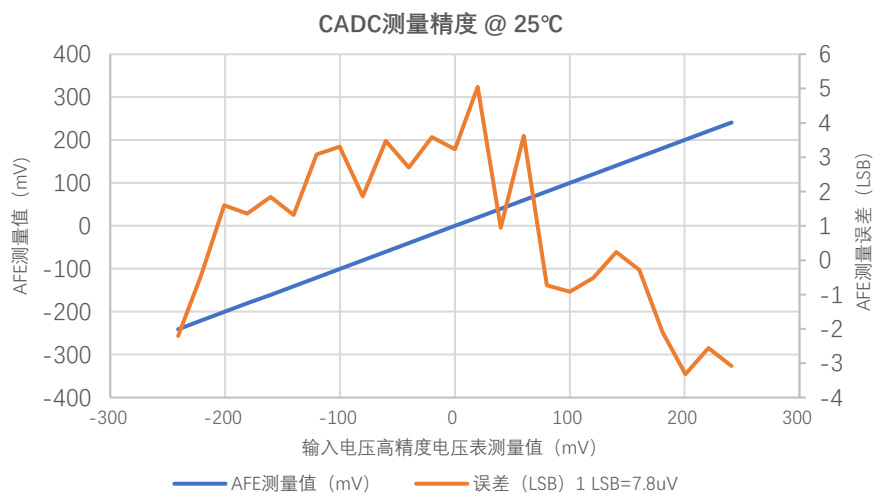


图 8.1 CADC 电流典型测量误差

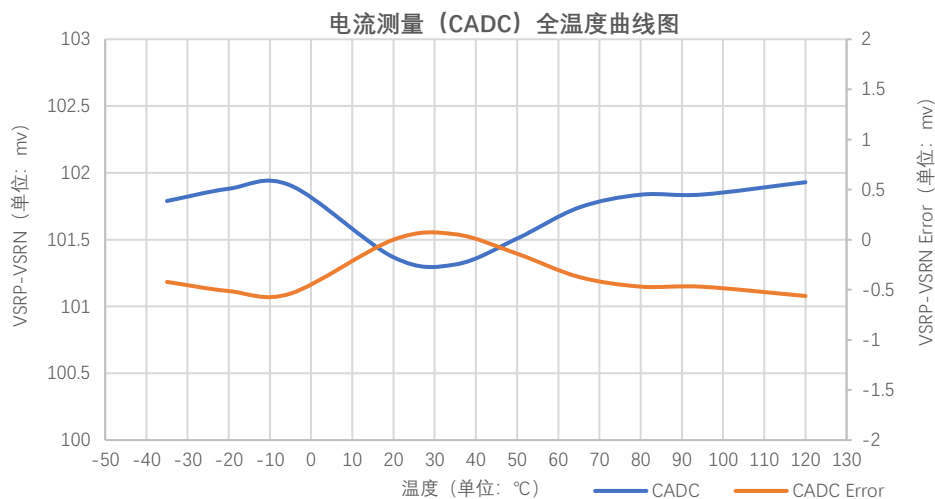


图 8.2 CADC 电流典型测量温度曲线

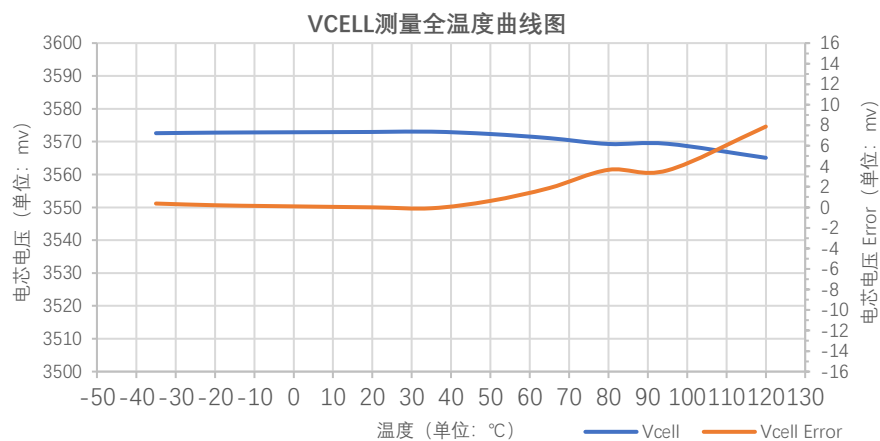


图 8.3 CELL 电压典型测量温度曲线

9 工作模式

PB7170P48 共有以下 4 种工作状态：测量模式，待机模式，睡眠模式，关机模式。各模式之间切换如下图所示。

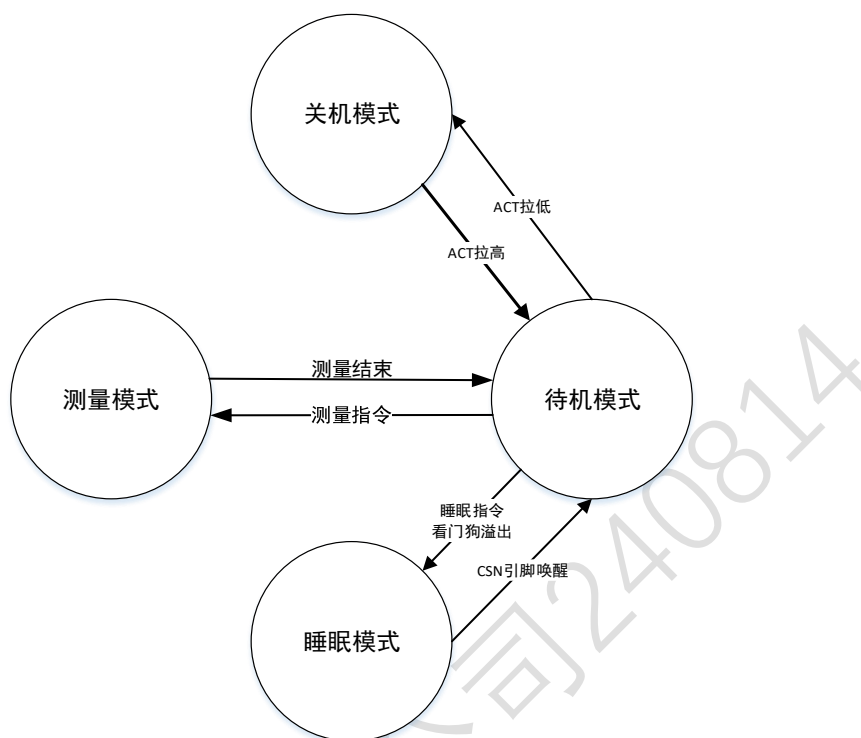


图 9 工作模式

9.1 关机模式

关机模式 (SHUTDOWN MODE) ——又称为运输模式，芯片最低功耗状态，电流小于 $2\mu\text{A}$ ，内部线性稳压器关闭，大部分模块禁用，内部状态被复位。可通过 ACT 引脚上拉或浮空自动激活进入待机模式。ACT 引脚强制拉低，芯片将进入关机模式，且不会进入其它工作模式。

9.2 待机模式

待机模式 (STANDBY MODE) ——芯片上电或被激活后默认进入此模式。该模式下 VADC 处于关闭状态。保护功能，CADC 测量，均衡功能开启。看门狗超时或者收到睡眠指令时，芯片由待机模式进入睡眠模式。进入睡眠后，可以通过 CSN 拉低一段时间，退出睡眠模式，进入待机模式。

9.3 测量模式

测量模式 (MEASURE MODE) ——芯片在待机模式下接收到 VADC 测量相关指令后，开启 ADC 相关电路进行 ADC 的测量。测量完成后 ADC 相关电路自动关闭，退出测量模式。

进入方式（满足以下任意一个条件）：

1. MCU 发出测量命令，VADC 的 SCAN 测量流程需要向 MSR_CMD 写入命令字触发，CADC 单次测量需要向 FUNC_CMD 写入固定参数触发。具体内容参考 10.1.1 章节)
2. 调度模式下自动进行测量，参考 10.2 章节。

9.4 睡眠模式

睡眠模式 (SLEEP MODE) ——该模式芯片功耗较低。该模式下，SPI 通信功能关闭。针对不同功耗场景，分为深睡眠和浅睡眠，两种睡眠模式通过寄存器位 DEEP 配置。

深睡眠：CADC，充放电电流保护，均衡等功能关闭，DRIVE 可选择开启，系统处于配置保持状态，功耗 5 μ A

浅睡眠：CADC，充放电电流保护，均衡，DRIVE 等功能可选择开启，功耗 40-90 μ A

进入方式（满足以下任意一个条件）：

- 1) MCU 发出睡眠命令（向 FUNC_CMD 写入 0xe453）进入睡眠模式，根据寄存器位 DEEP 选择进入深睡眠还是浅睡眠
- 2) 调度控制进入睡眠模式（浅睡眠）

退出方式（满足以下任意一个条件）：

- 1) MCU 拉低 CSN 引脚一段时间，唤醒芯片
唤醒时间：深睡眠为 1mS，浅睡眠为 250 μ S
- 2) 调度控制退出睡眠模式
- 3) 产生异常保护中断

CSN 作为唤醒引脚，通过外部拉低 CSN 来唤醒芯片：

- 1) 深睡眠下，CSN 需要提前拉低 1mS 唤醒芯片
- 2) 浅睡眠下，CSN 需要提前拉低 250 μ S 唤醒芯片

在睡眠状态时唤醒芯片，为了方便操作，建议通过连续读取 STATUS_MISC 寄存器 STA_WAKE 位来唤醒芯片：

- 1) 持续读取寄存器 STA_WAKE
- 2) 直到 STA_WAKE=1，并且 CRC 校验正确
- 3) 判断芯片处于唤醒状态

睡眠控制寄存器：

地址	0x3B	BIT[4]	BIT[1]
寄存器名称	SLEEP_CTRL	INT_WAKEUP_EN	DEEP
访问权限	读/写	读/写	读/写
默认值	0x31	0x1	0x0

INT_WAKEUP_EN：中断自动唤醒使能位

配置：“1”，睡眠过程中，产生中断，芯片自动唤醒

配置：“0”，睡眠过程中，产生中断，芯片不会自动唤醒

DEEP：深睡眠使能位

配置：“1”，芯片睡眠模式为深睡眠

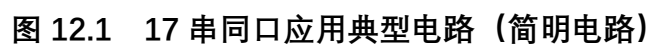
配置：“0”，芯片睡眠模式为浅睡眠

10 功能描述

深圳鹏申科技有限公司240814

12 应用指引

12.1 典型应用电路



12.2 功能设计

12.2.1 PB7170P48 功能图

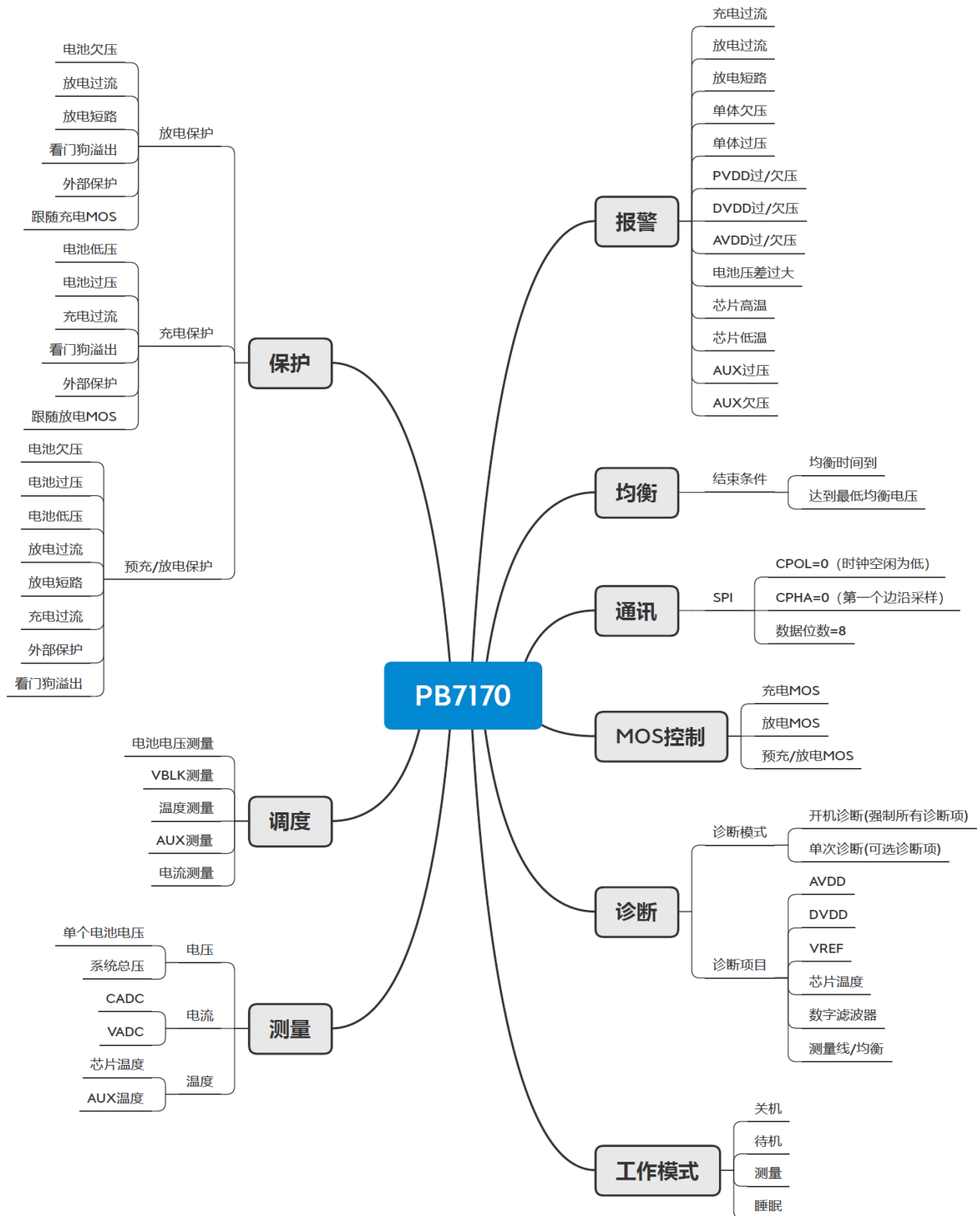


图 12.2 PB7170P48 功能图

12.2.2 中断功能使用

- 配置 ALRT_EN0 和 ALRT_EN1 寄存器，打开需要的中断
- 等待 ALERT 引脚由高变低（中断到来）
- 读取 ALRT_FLG0 和 ALRT_FLG1 寄存器，判断中断来源
- 对 ALRT_FLG0 和 ALRT_FLG1 寄存器中置起位写 1 清零
- 所有中断位被清零后 ALERT 引脚为高电平，等待下次中断到来

12.2.3 调度测量功能使用

- 配置 SCH_EN 打开调度功能
- 配置 SCH_VBLK、SCH_SIZE、SCH_INT 选择测量周期
- 配置 CADC_SIZE 配置 CADC 积分粒度
- （可选）配置 SCH_SLEEP_EN、INT_WAKUP_EN 选择调度时是否睡眠（降低功耗）

注：

- SCAN 完成会触发 MSR_DONE 中断
- 调度完成会触发 SCHEDULE_DONE 中断
- 推荐将 SCHEDULE_DONE 作为调度完成标志，MSR_DONE 用作单次测量完成判断
- $\text{SCAN 时间} = \text{SCAN 粒度} \times 62.5\text{ms}$
- $\text{调度中断时间} = \text{中断粒度} \times 62.5\text{ms}$
- $\text{MSR_DONE 中断时间} = \text{SCAN 粒度} \times 62.5\text{ms}$
- $\text{电流/AUXIN/温度/VBLK 测量时间} = \text{测量粒度} \times \text{SCAN 时间}$
- $\text{CADC 积分时间} = \text{CADC 积分粒度} \times 62.5\text{ms}$

基本颗粒	62.5mS
CADC 积分时间 (0-4)	$62.5 \times \text{配置时间}$
电池测量 (SCAN) 时间 (0 或 2^n , $n=0-5$)	$62.5 \times \text{配置时间}$
VBLK 测量时间 (0 或 2^n , $n=0-2$)	$\text{SCAN 时间} \times \text{配置时间}$
温度测量时间 (0 或 2^n , $n=0-2$)	$\text{SCAN 时间} \times \text{配置时间}$
AUX 测量时间 (0 或 2^n , $n=0-2$)	$\text{SCAN 时间} \times \text{配置时间}$
电流测量时间 (0 或 2^n , $n=0-2$)	$\text{SCAN 时间} \times \text{配置时间}$
调度中断时间 (2^n , $n=0-5$)	$62.5 \times \text{配置时间}$

注：括号中为可配置的值

12.2.4 外部 MOS 控制功能使用

- 配置 MOS_TRIG 寄存器控制 MOS
- 读取 MOS_TRIG 寄存器获得 MOS 当前状态

12.2.5 外部温度测量使用

- 配置 AUX_EN 选择需要使能的 AUXIN 通道
- (可选) 配置 SCHEDULE 寄存器进行调度测量
- (可选) 配置 MSR_CMD 寄存器进行单次测量
- 读取 AUXIN1-AUXIN5 寄存器获取测量结果

12.2.6 单次测量功能使用

- 配置 TYPE=1 选择 SCAN 测量
- 配置 AUX、VBLK、DIE TEMP、CELL、CURRENT 使能需要进行的测量
- (可选) 读取 CURRENT(0x9F)寄存器获得 VADC (电流快速测量) 结果
- (可选) 读取 CELL1-CELL17(0x87-0x97)寄存器获得电池电压测量结果
- (可选) 读取 TEMP(0x9E)寄存器获得芯片温度测量结果
- (可选) 读取 VBLK(0x86)寄存器获得电池包总电压
- (可选) 读取 AUXIN1-AUXIN5(0x98-0x9C)寄存器获得 AUXIN 端口的电压值

12.2.7 快速电流测量功能使用 (VADC 测量)

- (可选) 配置 CC_OPT 选择采样电阻电压放大倍数
- 配置 TYPE=1、CURRENT=1 进行 VADC 单次测量
- 读取 CURRENT 寄存器获得电流测量结果

12.2.8 内外部均衡功能使用

- 配置 BLSW_MODE 选择均衡模式
- 配置 BLSWEN 和 BLSWEN17 使能需要均衡的电池
- (可选) 配置 BLSW_THR_UV 设置均衡放电低压阈值
- 配置 BLSW_CMD 设置均衡放电时间

注: 满足放电低压阈值或放电时间结束都会结束均衡过程

12.2.9 睡眠唤醒

- 拉低 CSN 引脚
- 持续读取 STA_WAKE, 为 1 时芯片处于唤醒状态
- 拉高 CSN 引脚

注: 在唤醒过程中读取 STA_WAKE 时可能会发生 CRC 位错误, 此时 CRC 位错误可忽略, 在 STA_WAKE 为 1 且 CRC 校验正确 (ALRT_SPI=0) 时才认为芯片处于唤醒状态

12.2.9 保护功能

- (可选) 配置 MOS_SHUT_EN 选择关断 MOS 源头
 - 配置(0x1A-0x33)寄存器配置保护阈值
 - (可选) 配置 ALRT_EN0 和 ALRT_EN1 寄存器，打开需要的中断
 - 读取 ALRT_STAT0 和 ALRT_STAT1 寄存器，判断是否发生保护
 - (使能保护中断时) 捕捉到中断，读取 ALRT_FLG0 和 ALRT_FLG1，判断中断来源
- 以充电电池过压的保护功能示例

- (可选) 配置 CHG_CTRL_OV 选择关断 MOS 源头
- 配置 THR_OVCLR 配置电池过压保护退出门限
- 配置 THR_OVSET 配置电池过压保护置位门限
- (可选) 配置 FLG_EN_OV 选择是否启用中断
- 读取 ALRT_OV，判断是否发生保护
- (使能保护中断时) 捕捉到中断，读取 FLG_OV，判断是否发生保护

12.3 减少电芯串联数量应用规则

PB7170P48 可以支持最少 5 个电芯单元串联使用 (5S)，最多 17 个电芯单元串联使用 (17S)。5S 到 16S 应用推荐减少电芯串联数量应用的规则如下图所示：

引脚名	实际使用串数												
	17串	16串	15串	14串	13串	12串	11串	10串	9串	8串	7串	6串	5串
C17	●												
C16	●	●											
C15		●	●										
C14			●	●									
C13				●	●								
C12					●	●							
C11						●	●						
C10							●	●					
C9								●	●				
C8									●	●			
C7										●	●		
C6											●	●	
C5												●	●

注：从 CELL17 (C17 到 C16 短路) 开始依次连续按需短接，最多短接到 CELL6 (C6 到 C5 短路)，分别依次对应 16S~5S 应用。

图 12.3 减少电芯串联数量短接脚位示意图

通过配置相应寄存器关闭减少的相应电芯使能位：

地址	0x36	BIT[15:0]
寄存器名称	CELL_EN	CELL_EN16-1
访问权限	读/写	读/写
默认值	0xffff	0xffff

CELL_EN : CELL_EN16~CELL_EN1 的使能设置位，使能位默认全部开启。

地址	0x37	BIT[8]
寄存器名称	AUX_EN	CELL_EN17
访问权限	读/写	读/写
默认值	0x13f	1

CELL_EN17: CELL_EN17 的使能设置位，使能位默认开启。

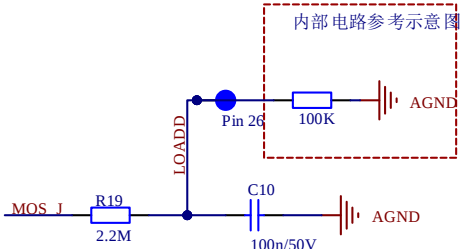
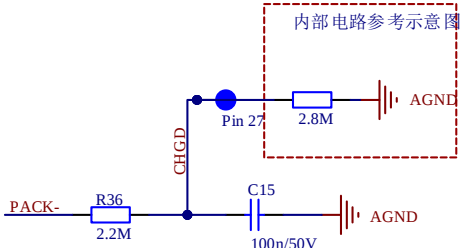
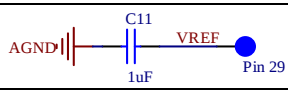
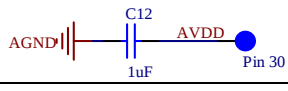
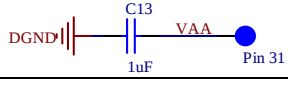
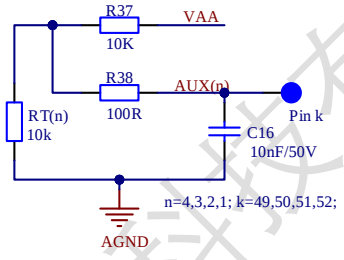
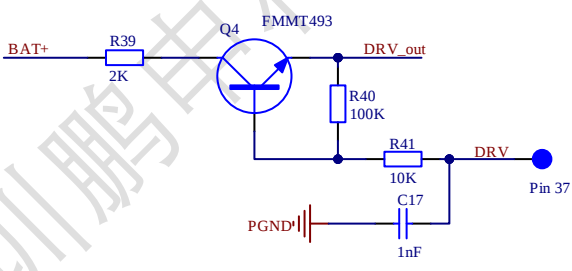
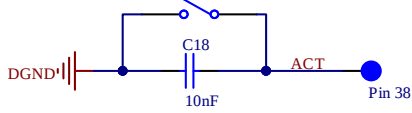
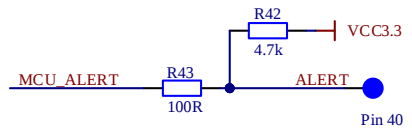
以上 17 个寄存器位配置：“1”，启用该串单体电压测量，配置：“0”，禁用该串单体电压测量

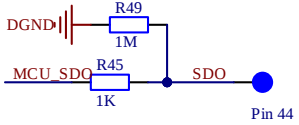
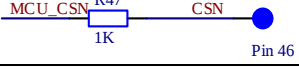
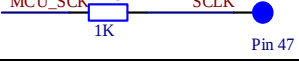
12.4 引脚端口电路说明

注：电路图中外围各器件参数仅供参考，需根据实际应用做相应调整。

脚位	引脚电压类型	引脚电路图	说明
1	DC		D1,R1 配合 ZD1,C1,C2 可对母线上暂态过程中可能产生的振铃进行有效衰减从而保护引脚免于过压击穿或避免 AFE 掉电重置。PVDD 端口电容推荐 100nF~1uF。
2	DC		Pin2 推荐放置 ZD2 连接到 PVDD 以避免上电过程中 C17 和 PVDD 之间出现瞬时过大的电压差。 R3,R4,R6,R7,R2,R8,R10,R11 为测量线电阻，推荐放置 2R (R3,R6,R2,R10) +100R (R4,R7,R8,R11) (BAT(n)-C(n)之间的总测量线电阻推荐为~100R)；C3,C4 为端口电容需放 1uF/X7R； D2,D3 为端口保护二极管，推荐使用 5.6~6.5V SOD123 封装的 TVS，或 5.6~6.5V 稳压管或不置件（根据实际测试结果来确定）。 D4,D5,R12 是为了限制 BAT0 和 PGND 的电压以解决装配过程中先插入测量线后接入功率地线时 BMS 的供电电流通过 Pin 36 流到 PGND 而造成 AFE 损坏，同时为了避免短路保护发生时对端口的冲击，必须接在
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

19			PGND 和 BAT0 之间。
20 28 48	DC		Pin20 为 PVDD 的参考地, Pin28 为模拟信号地, Pin48 为数字信号地, GND 为外部电路如 MCU 的信号地。 DGND, AGND 在 AFE PGND 脚 (Pin20) 附近单点连接。 GND 从合适的位置 (推荐 MCU VCC 电源输入电容处) 引出后同 PGND 及 BAT- (推荐尽量接近电流采样电阻处) 单点连接。
21 22	DC		SRN,SRP 对 PGND 电阻推荐保证 1KΩ 以下, 以保证对 PGND 的共模电压小于 2V, 否则 CADC 不能正常工作。 R_shunt 到 AFE 的走线建议采用开尔文法。 电流采样端口滤波电路参数推荐如左图所示, 且尽量靠近 AFE SRN,SRP 引脚。
23 25	DC		CHG 通道需要做防倒灌处理 (D8), 以避免 DSG MOS 关断且电池包负载未移除时 (此时 Pack- 几乎和 BAT+ 等电位) 过压击穿端口, 同时要避免 CHG MOS 在控制充电回路关断且充电器接入时 (此时 PACK- 相对 BAT- 是负电压) 误导通 (Q2)。 D6,D7 和 C5,C9 是为了吸收或衰减 MOS 关断时功率回路产生的振铃电压以避免击穿 MOS。 主回路的 MOS 驱动速度需要平衡, 过快会增加关断时功率回路的暂态振铃电压造成不必要的器件电压应力, 过慢会增加功率回路里器件电流/功耗应力。建议在满足各器件电流/功耗应力的前提下尽可能慢。
24	DC		Pin41 为 PreMOS 引脚, 可以同时控制 PreCHG 和 PreDSG MOS。 PreCHG 通道需要做防倒灌处理 (D10), 以避免 DSG MOS 关断且电池包负载未移除时 (此时 Pack- 几乎和 BAT+ 等电位) 过压击穿端口, 同时要避免 PreCHG 在控制充电回路关断且充电器接入时 (此时 PACK- 相对 BAT- 是负电压) 误导通 (D9 和 Q3)。

26	DC		R19 应取尽量大的值以减少在 DSG 关断且电池包负载未移除时（此时 Pack- 几乎和 BAT+ 等电位）端口的漏电流，约束条件是在负载接入(DSG MOS 断开)时 V_LODD 大于检测阈值 (Max: 1.7V)。
27	DC		R36 应取尽量大的值以减少在 DSG 关断且电池包负载未移除时（此时 Pack- 几乎和 BAT+ 等电位）端口的漏电流，约束条件是在充电器接入(CHG MOS 断开)时 V_CHGD 小于检测阈值 (Min: -0.95V)。
29	DC		端口电容推荐 1uF。
30	DC		端口电容推荐 1uF。
31	DC		端口电容推荐 1uF。
32 33 34 35	DC		推荐使用 VAA 端口作为偏置电源，因为 VAA 是在 AFE 执行 AUXIN 测量时才打开所以注意端口电容值推荐为 10nF（对应 RT(n) 为 10K NTC），如果偏置电源选用稳定的 DC 电压，那么可以放更大的端口电容值。
37	DC		端口需要放置 1nF 电容抑制输出电压波动。 建议使用缓冲器以避免 AFE 直接承受线性调压器的损耗。 DRV_out 的输出电流控制在 10mA 以内以避免过大的功耗。
38	DC		端口被拉低后 AFE 进入输出模式。 ACT 使用机械开关或跳针。
40	DC		AFE 上报中断脚，如果 MCU 主动下拉则会触发 AFE 外部保护功能。 需要外部上拉电阻。
41	DC	PROG	直接接地或浮空
42	DC		通用输入输出口，默认浮空，详见端口配置定义章节 10.5
43	AC		

		GPIO	
44	AC		最高频率 2MHz。 需要外部下拉电阻，推荐 1M。 在 CSN 为高电平且 AFE 不处于睡眠时 SDO 脚为低电平输出。
45	AC		最高频率 2MHz
46	DC		片选信号，低电平有效。
47	AC		最高频率 2MHz

12.5 注意事项

- 建议 PVDD 和 C17 同步上电，规避由 Cn 引脚供电导致的芯片供电不正常。
- 必须要 AFE 的 PVDD 上电完成后再接入负载以避免上电时 MOS 开关状态不定导致的放电打火。
- 低串应用时，需短路电芯单元建议在 AFE 的 Cn 引脚处进行，即短路 AFE 端口并联的电容，可以最优化系统 ESD 性能。（参考图 12.1）
- 低功耗方案时 AFE 的 DRIVE 参与供电方案中，在 DRIVE 引脚挂载合适的电容，并建议在输出位置加上合适的稳压管（如 ZD101）或先经过线性调压器的输入，以提供 MCU 更稳定的供电。（参考图 12.1）
- 电池包线束接入 BMS 时最好从 BAT0 开始依次从低压端接入以避免对 AFE 芯片端口的过度冲击。

12.6 PCB 布线指引

- 推荐将 AFE 的 DGND，AGND，PGND 星形连接，再单点连接到 BAT0/BAT-供电端，其余 BMS 器件供电 GND 另单点连接至 BAT0/BAT-供电端。
- 注意如果 BAT+从 BAT17 针脚接入处，单独给予后续 PVDD 供电，给予 MOS 驱动部分的 BAT+供电需要单独从 BAT17 针脚接入处引出，规避电源交叉干扰。
- 注意 SRP 和 SRN 引脚串联的电阻(如图 12.1 17 串同口应用典型电路(简明电路)中的 R143 和 R142)接电流采样电阻端的走线最好单独连线到电流采样电阻两端焊盘处（开尔文接法），严格采用差分线走线。
- 单体电压测量线尽量平行等长走线（开尔文接法）
- MOS 等走功率大电流的线路建议适当开窗喷锡处理以增强散热

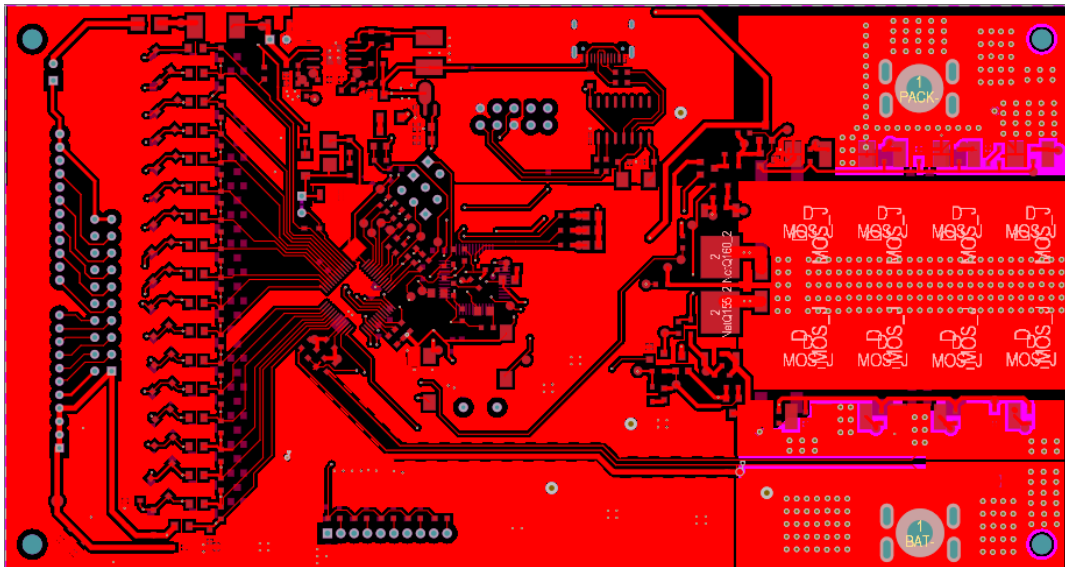


图 12.6.1 应用板（160mmX86mm）顶层布线示例

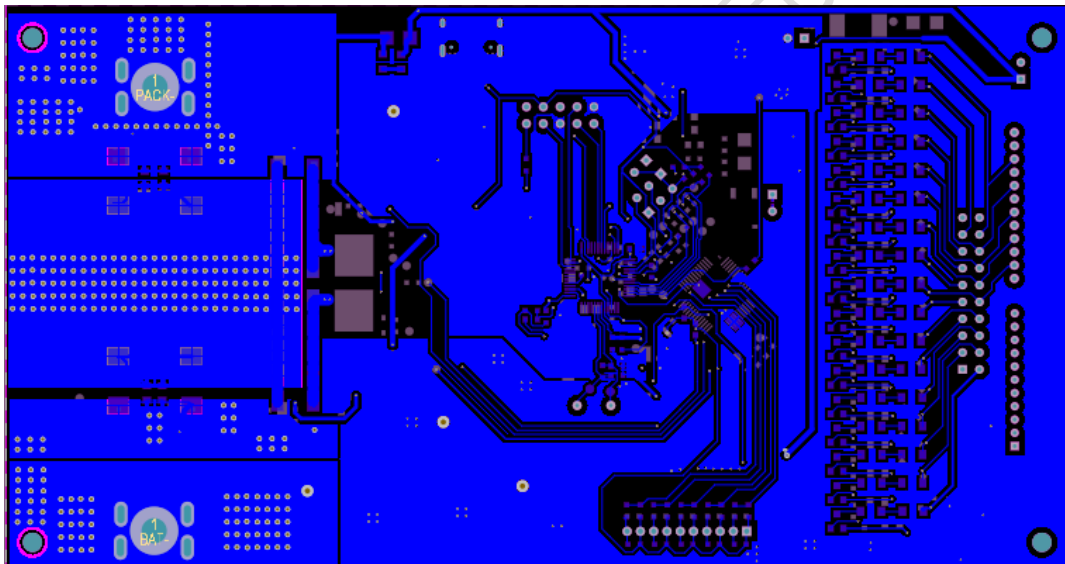
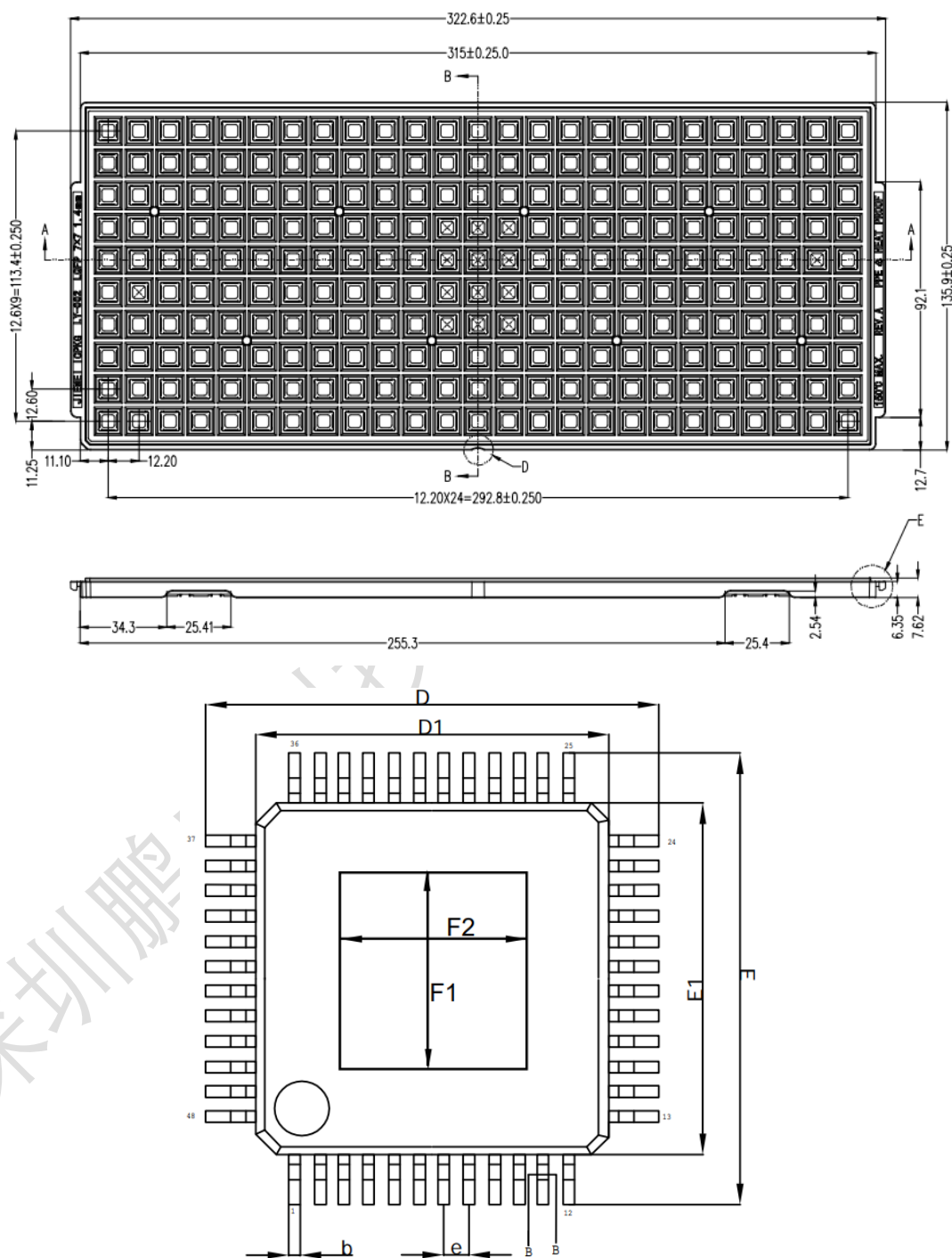
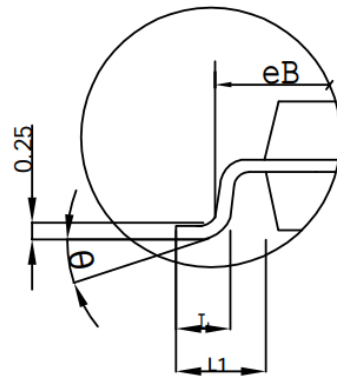
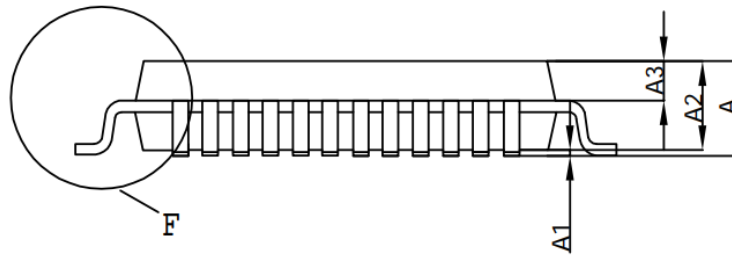


图 12.6.2 应用板（160mmX86mm）底层布线示例

13 包装

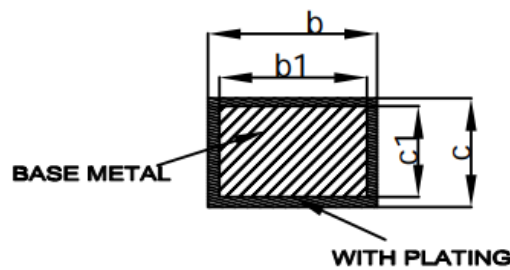
13.1 包装和器件机械尺寸





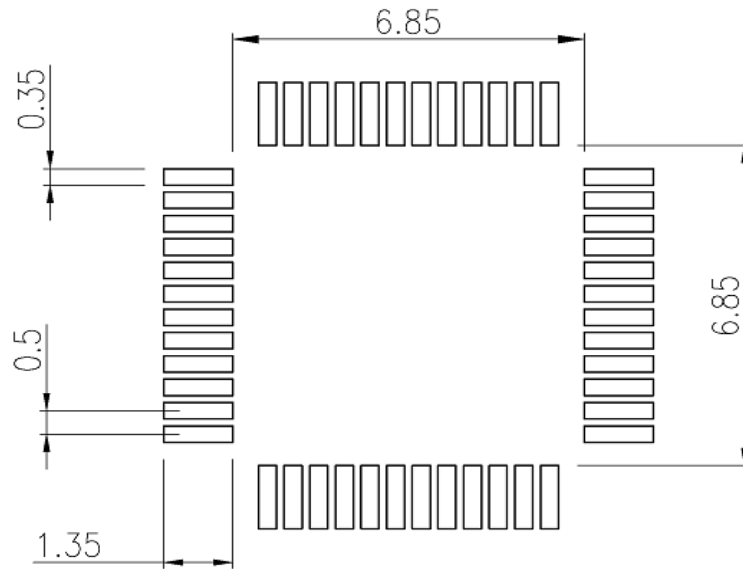
DETAIL F

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	----	----	1.60
A1	0.05	----	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.60	----	0.64
b	0.18	----	0.26
c	0.13	----	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
eB	8.10	----	8.25
e	0.50BSC		
L	0.40	----	0.65
L1	1.0REF		
θ	0°	----	8°
F1	2.90	3.00	3.10
F2	2.90	3.00	3.10



13.2 器件焊盘设计推荐

PB7170P48 采用标准的 LQFP48 封装。



单位: mm